HfZrO_x膜の結晶構造同定・含有割合の算出

XRD・XAFSによる複合解析で、より詳細な評価が可能

測定法 :XRD • XAFS 製品分野:LSI・メモリ 分析目的:構造評価

概要

high-k材料や強誘電体として注目されているHfZrO、膜は、結晶構造によって誘電率等の物理的性質が 大きく変化することから、結晶構造の同定・各結晶構造の含有割合の算出が重要な評価項目です。 通常XRDやXAFSによって評価可能ですが、一方の手法だけでは詳細な解析が困難な場合でも、これら 2つの手法を組み合わせることでより詳細な情報が得られます。今回、XRDとXAFSの複合解析によって、 HfZrO、膜の結晶構造の同定および、各結晶構造の含有割合の算出を行った事例を紹介します。

【XRD】 主に結晶構造の同定 【XAFS】元素選択的な局所構造解析

[長距離秩序] [短距離秩序]

原理の異なる手法の複合解析により 相補的な分析が可能

■試料構造 ■In-Plane XRD HfZrO_v(10nm) 下部電極(30nm) intensity(a.u.) Si基板 評価項目 結晶構造の同定 各結晶構造の 含有割合の算出 26

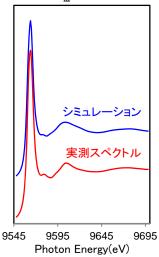
m o,t,(c) m 28 30 $2\theta\chi(deg)$

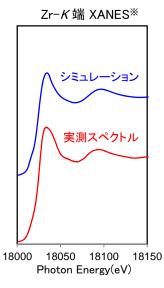
✓ XRDによる 結晶構造の同定

- 斜方晶(o)・正方晶(t)がメイン、 単斜晶(m)は極微量 ※立方晶(c)は他回折ピーク より非検出を確認
- 斜方晶(o)と正方晶(t)の 回折パターンが近接しているため 切り分けは困難
 - ⇒XAFSとの複合解析

■XAFS

Hf-Lπ端 XANES**





√ XAFSによる 各結晶構造の含有割合の算出

斜方晶(HfO。)

正方晶(HfO。)





結晶構造	割合
斜方晶	0.73
正方晶	0.27

XXANES: X-ray Absorption Near Edge Structure

般財団法人 ₩ ★ 対料科学技術振興財団

URL : http://www.mst.or.jp/